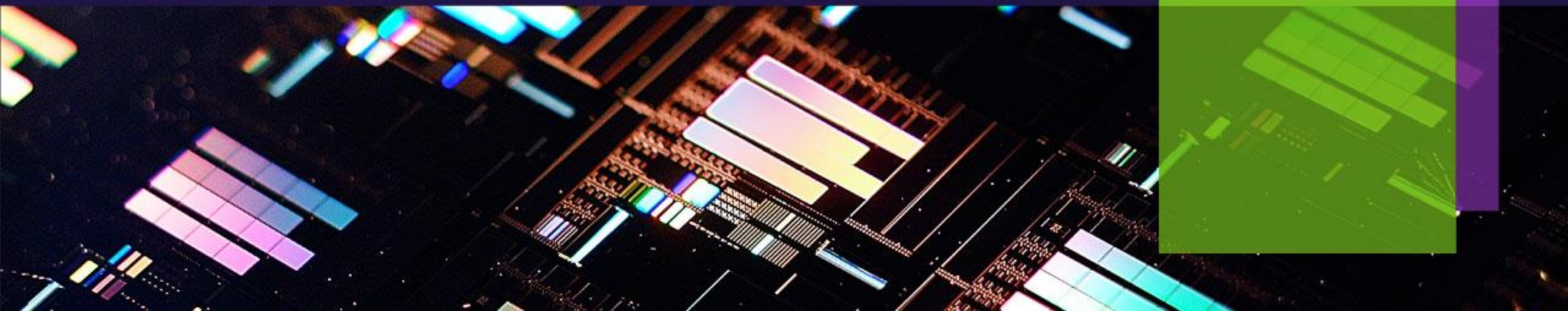


## 2023年3月期 第2四半期（2022年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2022年11月10日

内容：

- 連結決算の概要 執行役員 ファイナンスユニットGM 川本 弘
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、地政学的リスク、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

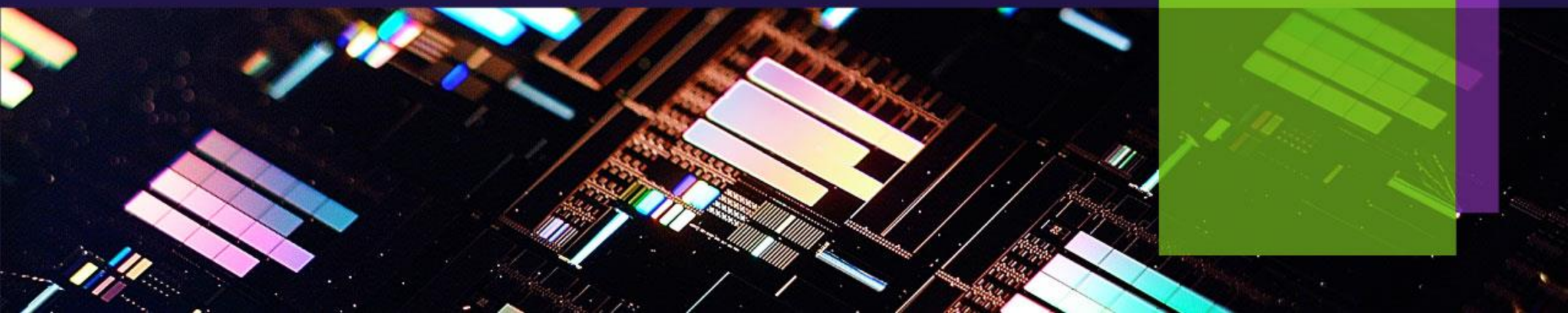
当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 第2四半期 連結決算の概要

2022年11月10日

川本 弘  
執行役員 ファイナンスユニットGM



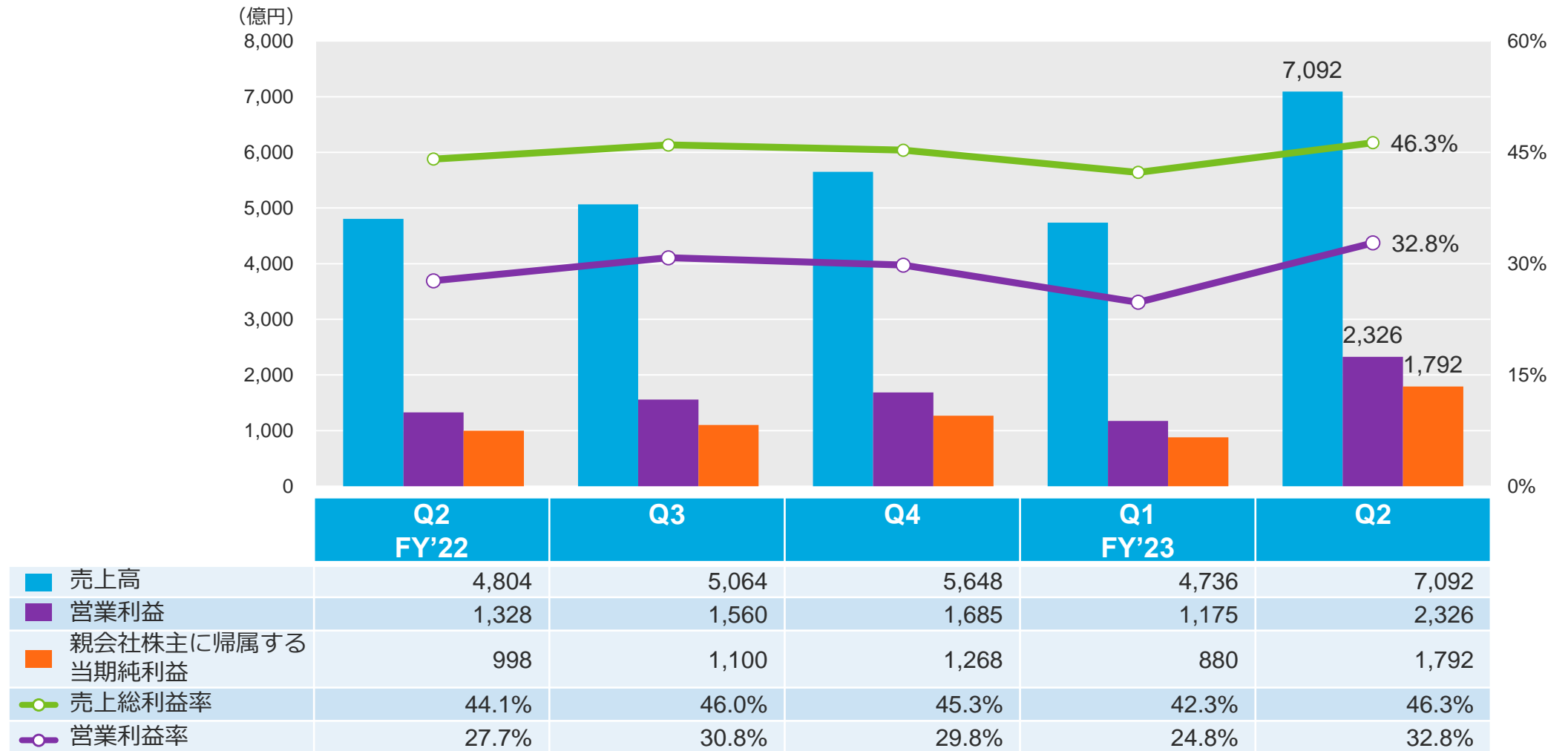
# 損益状況（四半期）

（億円）

	FY2022			FY2023		対FY2023 Q1 増減
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
売上高	4,804	5,064	5,648	4,736	7,092	+49.7%
SPE	4,678	4,888	5,492	4,640	6,890	+48.5%
FPD	125	176	155	96	201	+109.5%
売上総利益	2,119	2,330	2,559	2,005	3,282	+63.7%
下段：売上総利益率	44.1%	46.0%	45.3%	42.3%	46.3%	+4.0pts
販管費	790	769	873	830	956	+15.2%
営業利益	1,328	1,560	1,685	1,175	2,326	+98.0%
下段：営業利益率	27.7%	30.8%	29.8%	24.8%	32.8%	+8.0pts
税金等調整前当期純利益	1,350	1,555	1,681	1,176	2,352	+100.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	998	1,100	1,268	880	1,792	+103.5%
研究開発費	411	385	441	421	491	+16.8%
設備投資額	145	174	147	180	173	-3.9%
減価償却費	88	96	102	97	98	+1.8%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# 損益状況（四半期）



# 損益状況（半期）

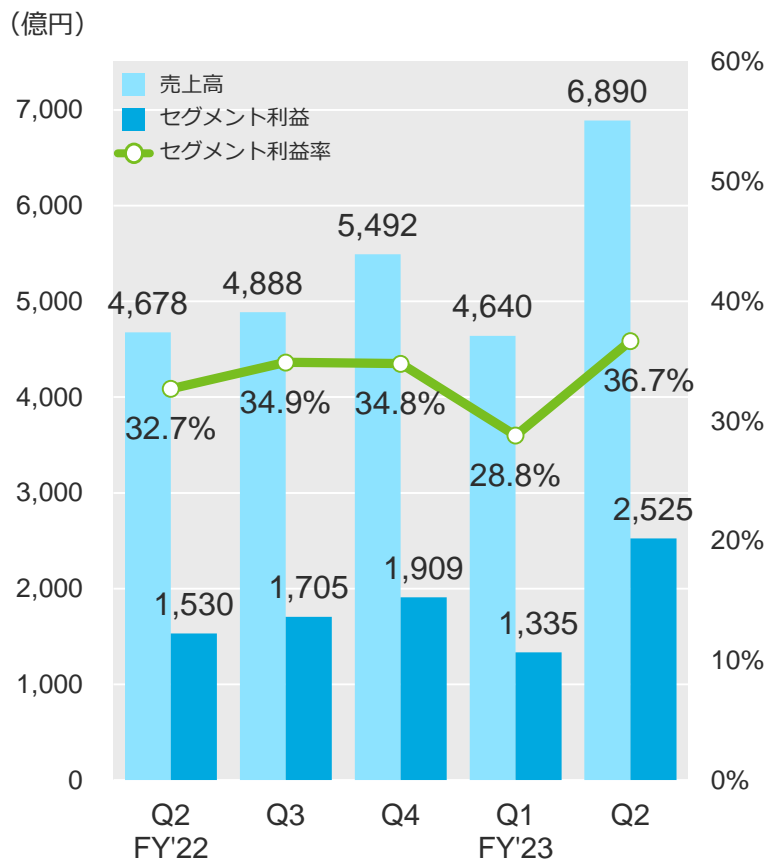
（億円）

	FY2022		FY2023	（ご参考） 8月8日発表の FY2023 H1予想
	H1	H2	H1	
売上高	9,325	10,712	11,828	11,000
SPE	9,057	10,380	11,530	10,700
FPD	266	331	297	300
売上総利益	4,228	4,889	5,288	4,950
下段：売上総利益率	45.3%	45.6%	44.7%	45.0%
販管費	1,482	1,643	1,786	1,760
営業利益	2,746	3,246	3,501	3,190
下段：営業利益率	29.5%	30.3%	29.6%	29.0%
税金等調整前当期純利益	2,730	3,236	3,529	3,190
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,002	2,368	2,673	2,340
研究開発費	755	827	913	
設備投資額	251	321	354	
減価償却費	167	199	196	

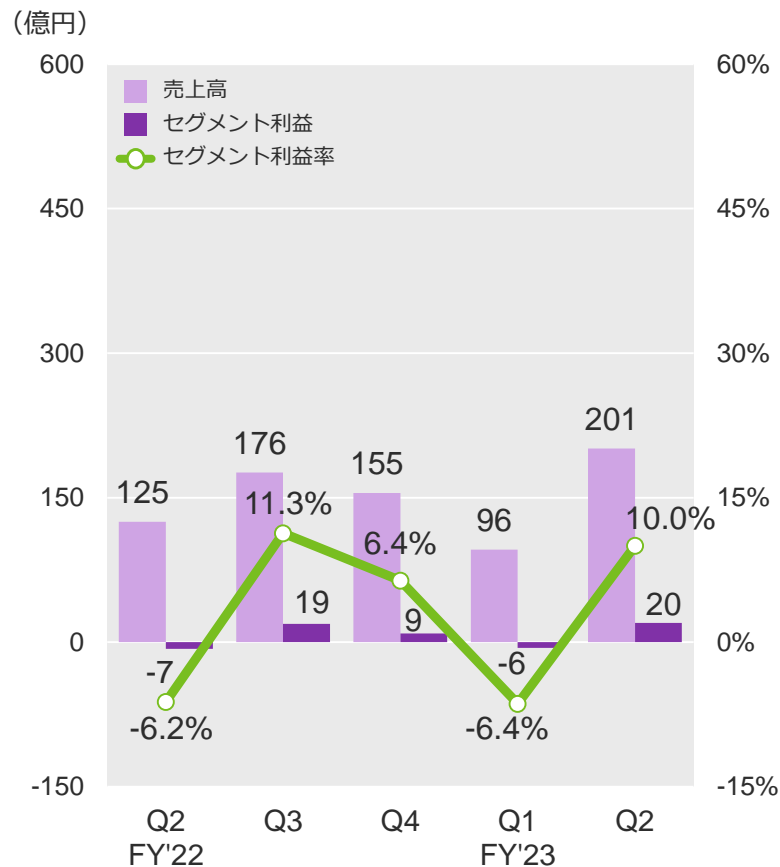
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# セグメント情報

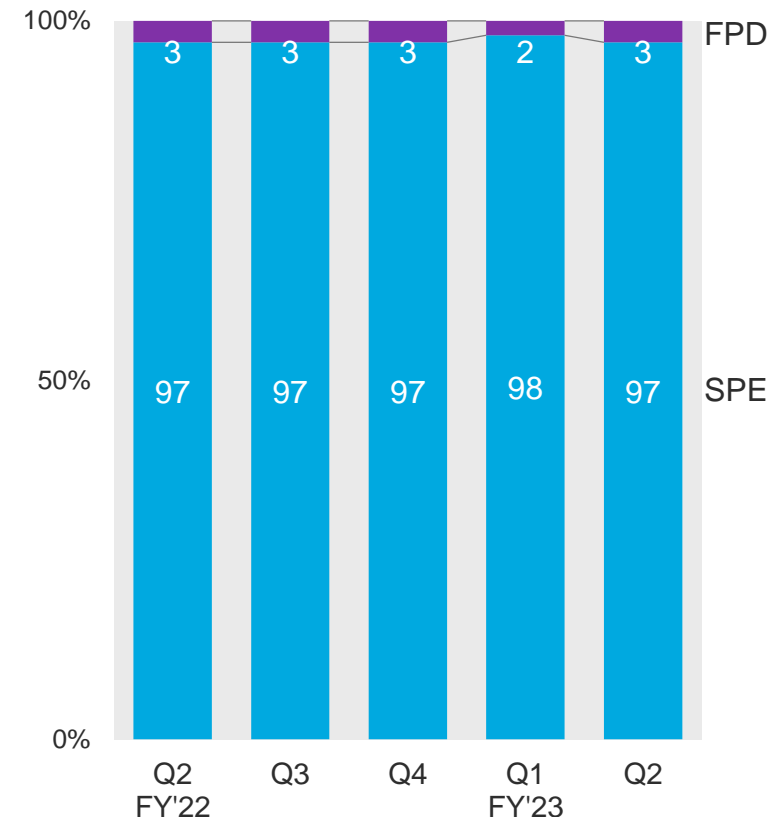
## SPE (半導体製造装置)



## FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



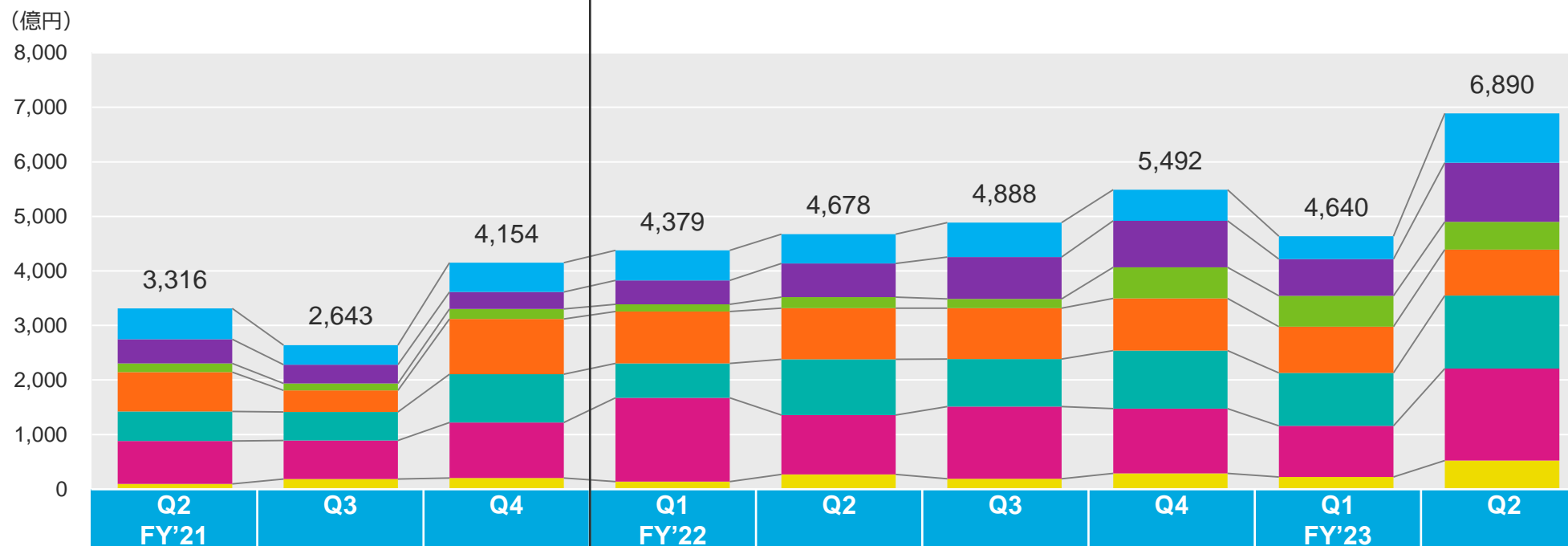
## 売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 地域別売上高

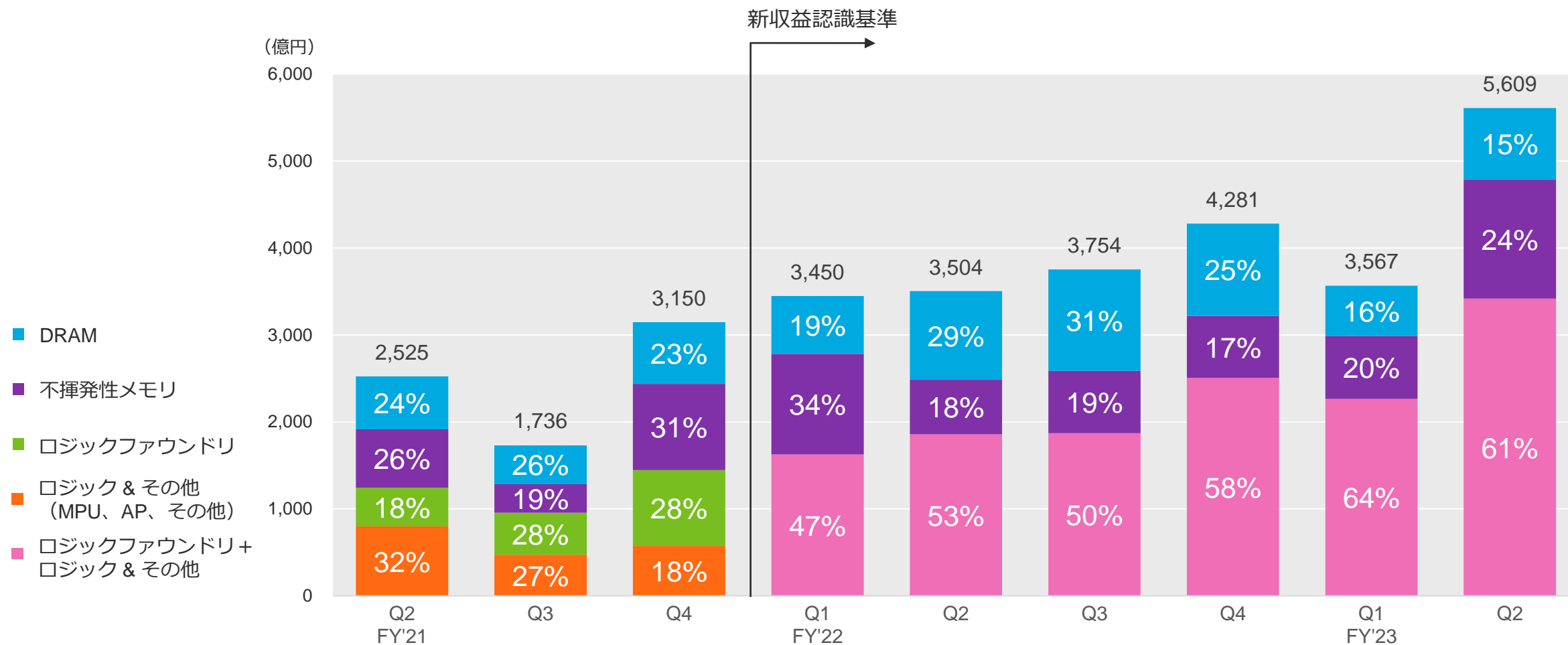
新収益認識基準



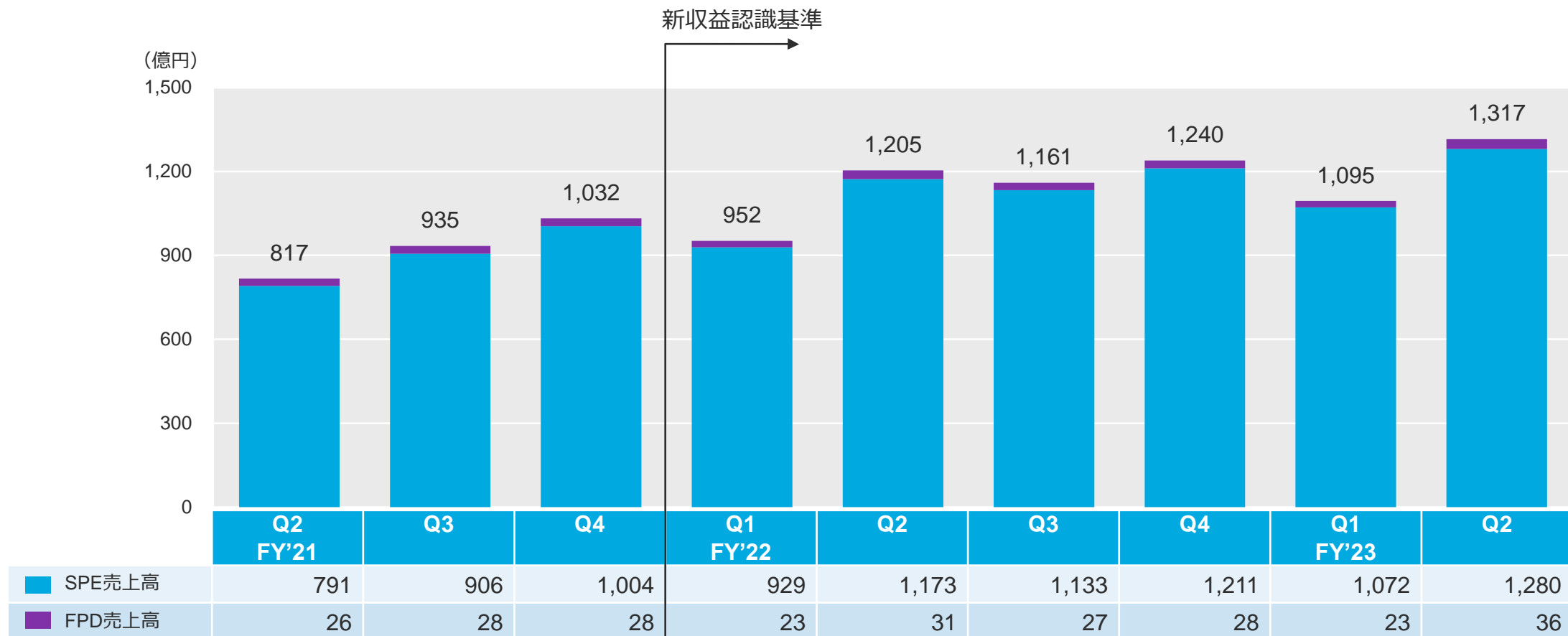
■ 日本	568	361	536	548	539	631	569	420	905
■ 北米	440	345	312	439	618	768	853	673	1,083
■ 欧州	163	127	186	134	203	170	571	565	509
■ 韓国	721	393	1,014	953	935	930	959	851	842
■ 台湾	539	525	882	628	1,025	874	1,063	968	1,338
■ 中国	791	705	1,022	1,536	1,088	1,322	1,188	940	1,686
■ 東南アジア・他	92	184	200	138	267	189	287	220	525



# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



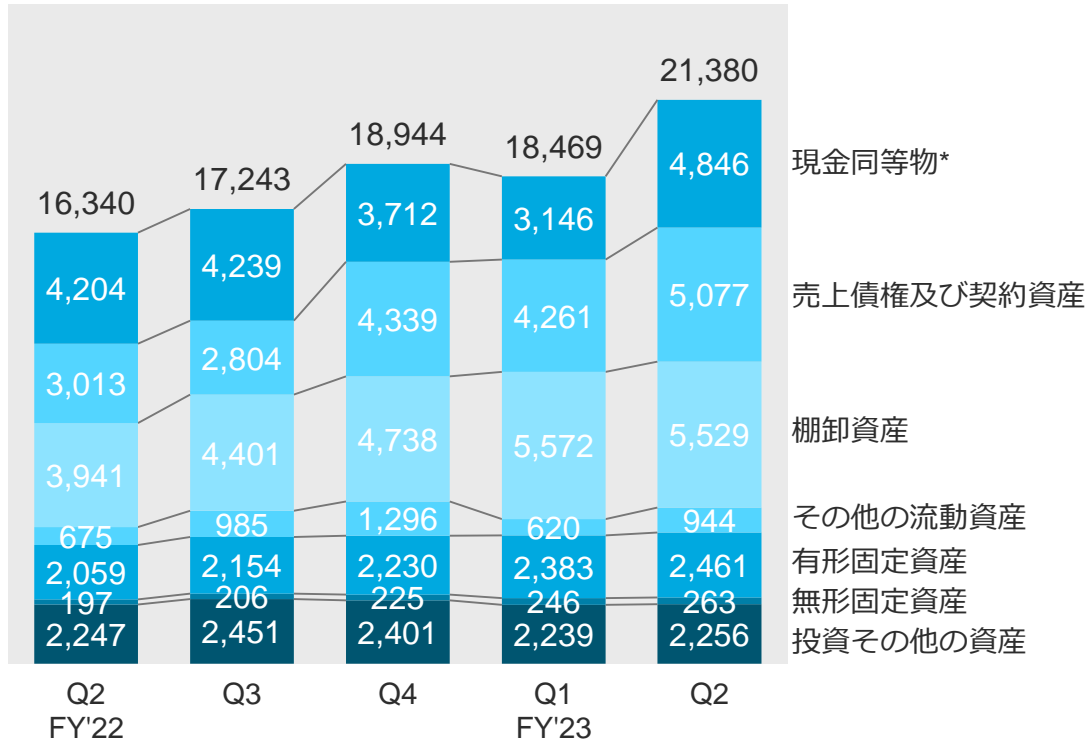
# フィールドソリューション売上高



# 貸借対照表

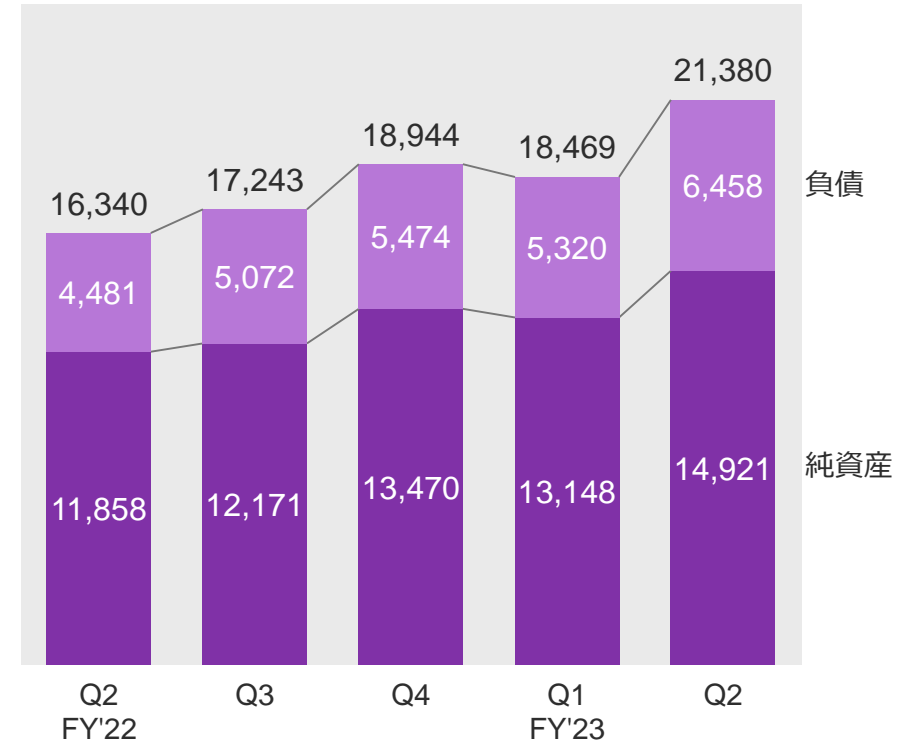
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

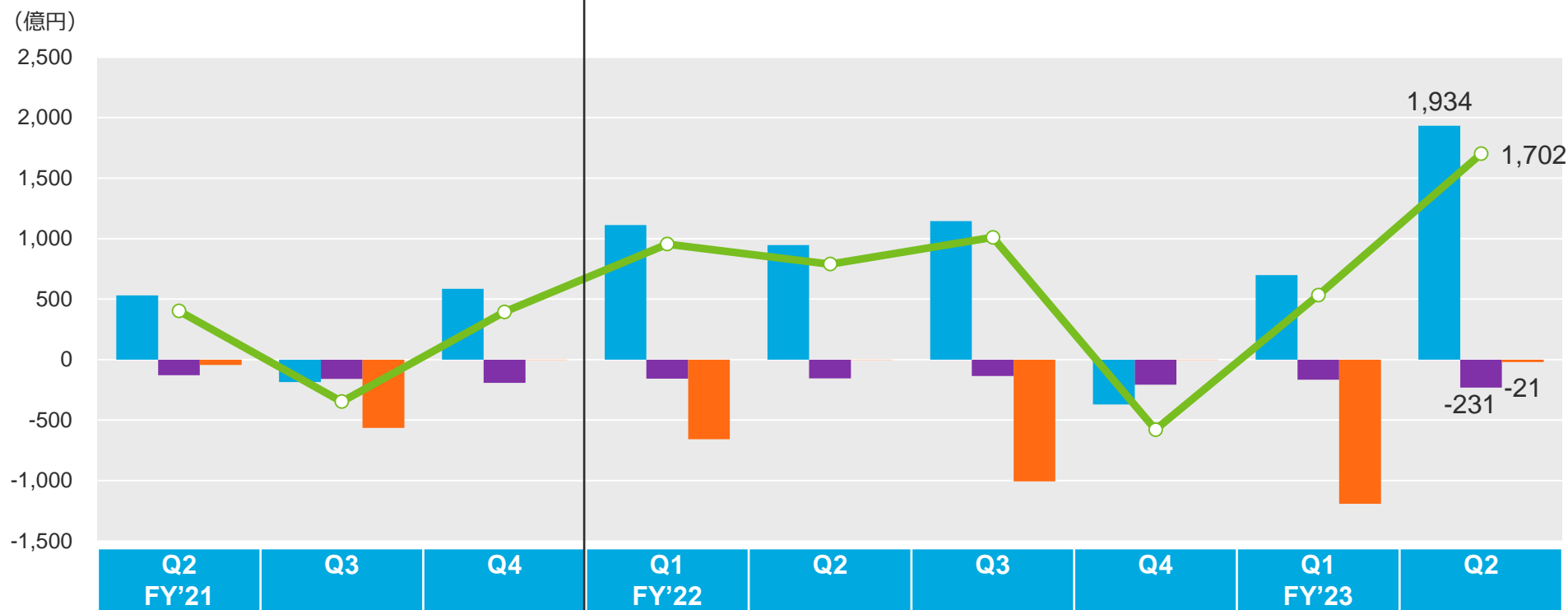
(億円)



\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# キャッシュ・フロー

新収益認識基準



	Q2 FY'21	Q3	Q4	Q1 FY'22	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'23	Q2
営業キャッシュ・フロー	531	-186	586	1,112	946	1,146	-371	699	1,934
投資キャッシュ・フロー*1	-128	-160	-191	-157	-155	-135	-207	-166	-231
財務キャッシュ・フロー	-44	-564	-1	-659	-2	-1,007	-2	-1,191	-21
フリーキャッシュ・フロー*2	402	-347	394	955	790	1,010	-579	533	1,702
手元資金残高*3	3,589	2,690	3,115	3,417	4,204	4,239	3,712	3,146	4,846

\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

\*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

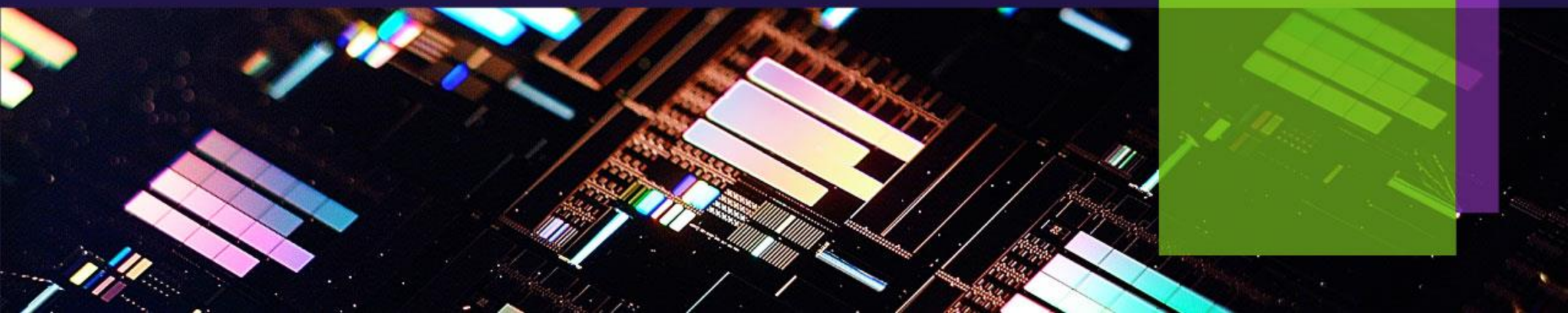
\*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。



# 事業環境および業績予想

2022年11月10日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



# CY2022 事業環境 (2022年11月時点での見方)

- 半導体前工程製造装置 (WFE)\*<sup>1</sup> 市場

- 前年比+10%程度の成長を見込む。  
社会のデジタルシフトの進展による中長期的な成長に対する見方に変更なし

- FPD製造装置市場 (TFTアレイ工程\*<sup>2</sup> 向け)

- 前年比微増を見込む。  
車載など新たなアプリケーションやモバイルの新技术採用に伴う投資が増加。  
LCDからOLEDへの移行は小型パネルから進行しており、今後は大型パネルへの展開も期待

\*1 半導体前工程製造装置 (WFE; Wafer fab equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*2 TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

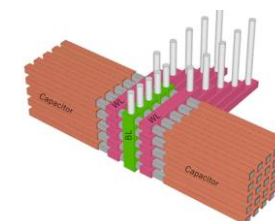
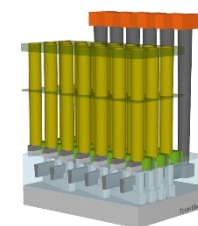
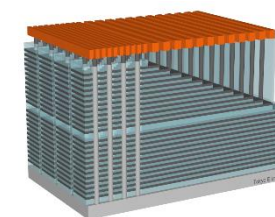
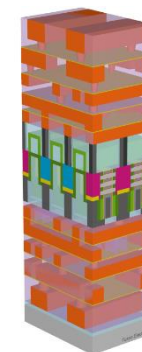
# FY2023 Q2 事業進捗

- 過去最高の四半期売上 7,092億円、営業利益率 32.8%
  - ロジック、NAND向け売上が全プロダクトにて大幅に拡大
  - フィールドソリューション事業は、メモリの微細化および多層化に向けたアップグレード・改造が増加
- 調達・物流の混乱を乗り越え、大規模な生産・出荷を達成
  - 中期経営計画目標：売上高 ≥ 3兆円の達成に向け、環境変化への対応力（ダイナミック・ケイパビリティ）を確認。当社のもつ強固なサプライチェーンを再認識
- 戦略製品によるPOR\*獲得や、将来成長に向けた開発装置選定も順調に進捗

\*POR（Process of record）：顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

# 主なハイライト

- 洗浄装置：先端ロジック向け 両面同時処理を実現した次世代スクラバー、  
パワー半導体向け洗浄 POR獲得
- 成膜装置：各種評価機導入が進む
  - ①先端ロジック向け新低抵抗メタルCVD、②メモリ向けHKMG\*1用枚葉CVD、  
③新規アプリ・次世代マスクPVDSiCパワー半導体向けALD POR獲得
- エッチング装置：HARCエッチング向け新規装置、  
新構造向けガスケミカルエッチング装置の評価が進捗
- コータ/デベロッパ：High-NA EUV向け研究開発、MOR\*2 対応 順調に進捗
- ボンディング装置：NANDでの採用、およびBackside PDN\*3向け 評価進展
- Laser Edge Trimming：環境負荷低減に向け引き合い多数、評価進行中
- プローバ：NAND向け新テスター搭載 POR獲得
- インテグレーション：DRAM向け 複数装置によるソリューション提案、  
コラボレーション開始



\*1 HKMG: High-k Metal Gate

\*2 MOR: Metal Oxide Resist

\*3 PDN: Power Delivery Network



# FY2023 業績予想

# FY2023 業績予想

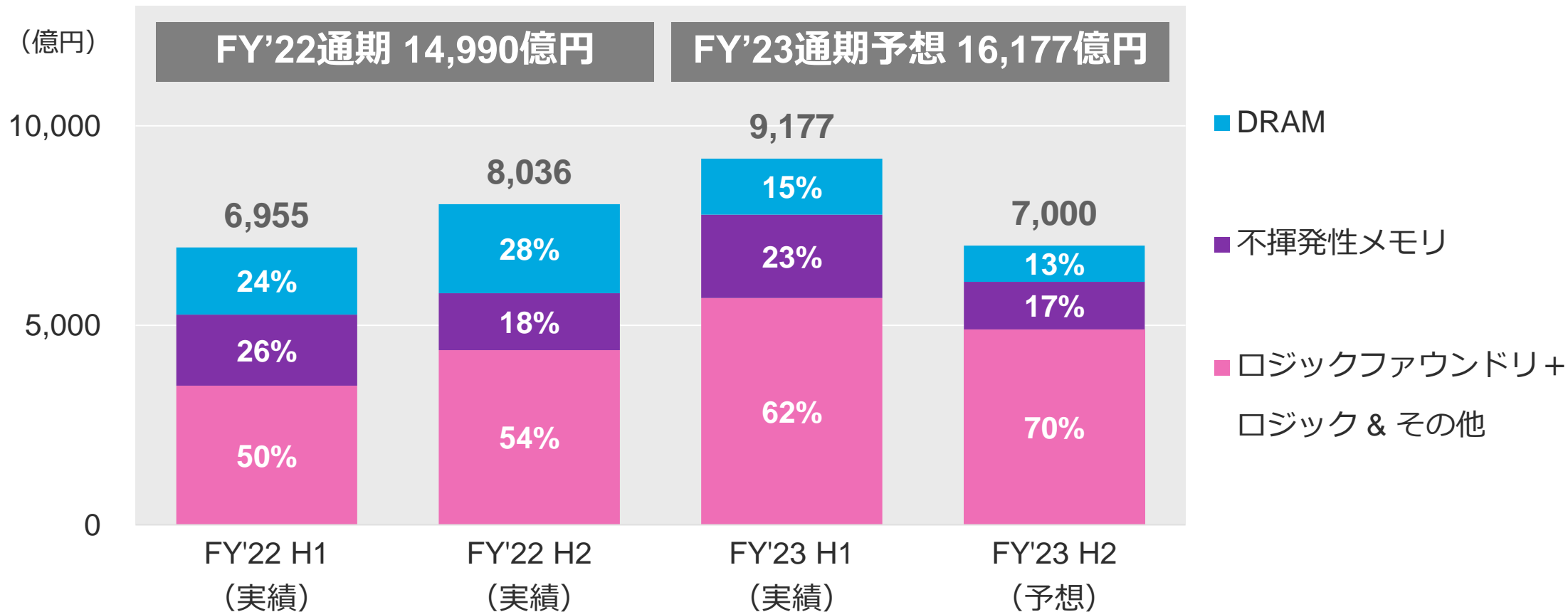
\*修正額：2022年8月8日に発表した業績予想からの修正額を示しています。（億円）

	FY2022	FY2023			
	実績	実績	新予想		修正額
	通期	H1	H2	通期	通期
売上高	20,038	11,828	9,171	21,000	-2,500
SPE	19,438	11,530	8,929	20,460	-2,490
FPD	598	297	243	540	-10
売上総利益	9,118	5,288	3,812	9,100	-1,650
下段：売上総利益率	45.5%	44.7%	41.6%	43.3%	-2.4pts
販管費	3,125	1,786	1,853	3,640	+50
営業利益	5,992	3,501	1,958	5,460	-1,700
下段：営業利益率	29.9%	29.6%	21.3%	26.0%	-4.5pts
税金等調整前当期純利益	5,966	3,529	1,961	5,490	-1,670
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	2,673	1,326	4,000	-1,230
1株当たり当期純利益 (円)	2,807.84	1,715.27	-	2,564.93	-792.70

半導体メーカーの設備投資計画の変更を反映し、業績予想を修正

# FY2023 SPE部門 新規装置売上予想

## アプリケーション別売上構成比

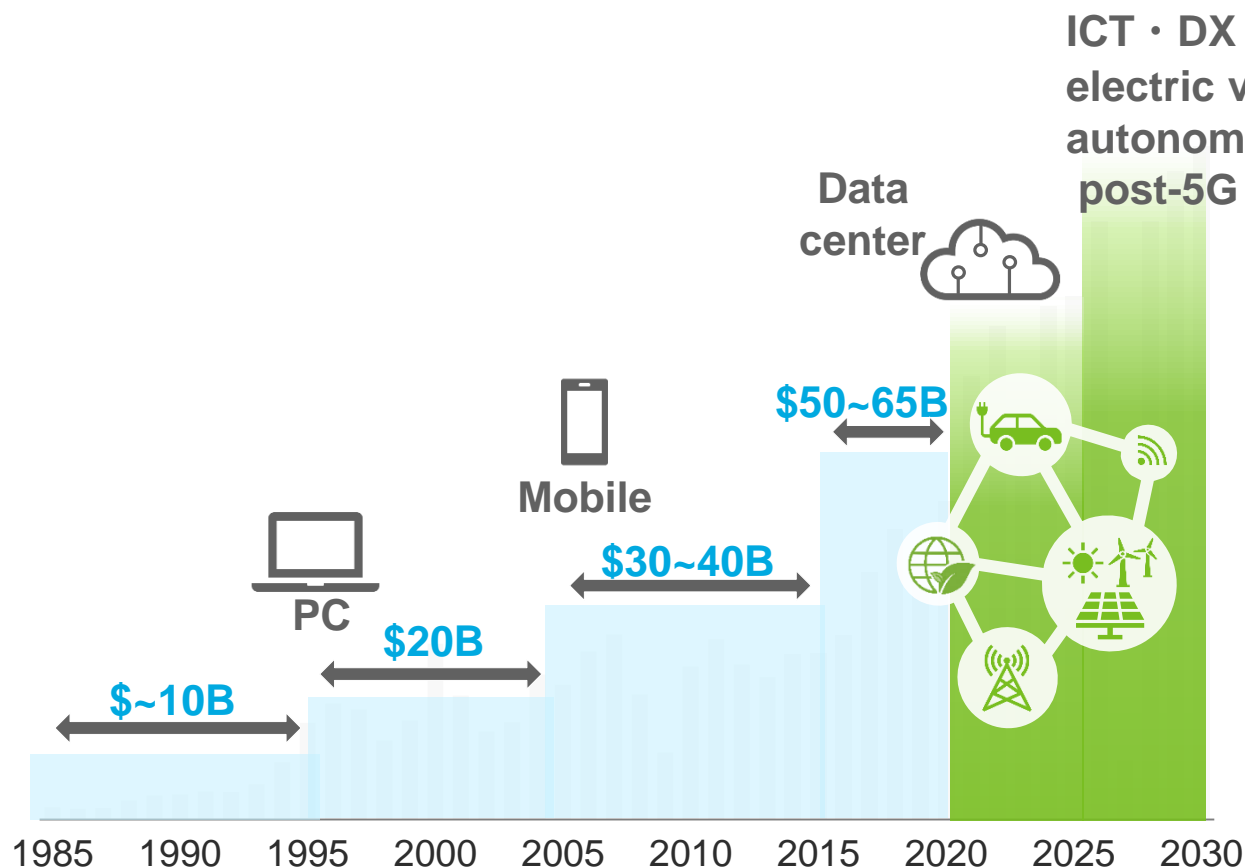


CYベースでは約20%の成長を見込む。

FYベースでも過去最高を達成した前年通期に対し約8%の成長

# 中長期成長に向けた取り組み

# WFE Market



“SEMI is currently tracking 67 new 300mm fabs or major additions of new lines expected to start construction from 2022 to 2025.”

Ajit Manocha, SEMI President and CEO  
October 11, 2022

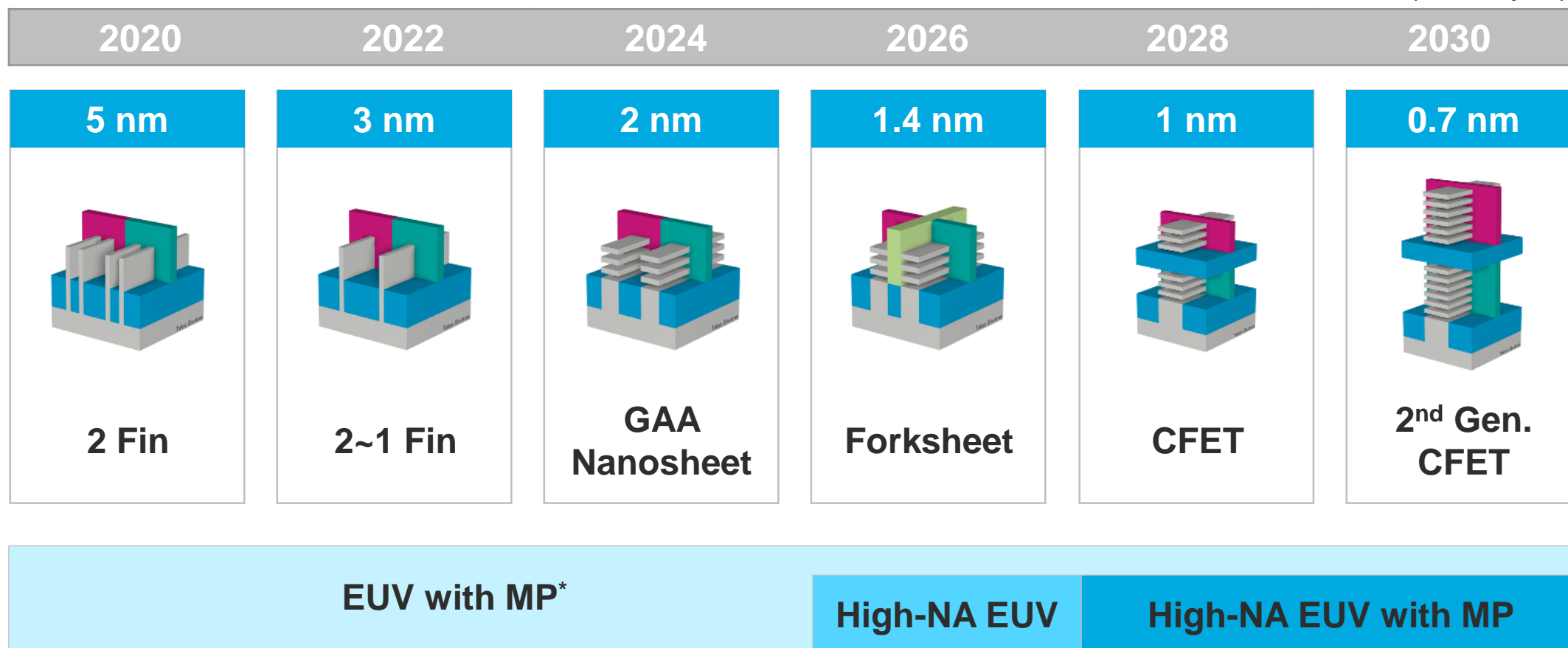
Source : Techinsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI)(1985-2021) のデータを元に当社作成

WFE市場は中長期的に成長を継続。

2022~25年に67の300mm新工場・ラインが建設見込み

# ロジックデバイス構造とEUVリソグラフィ技術の進化

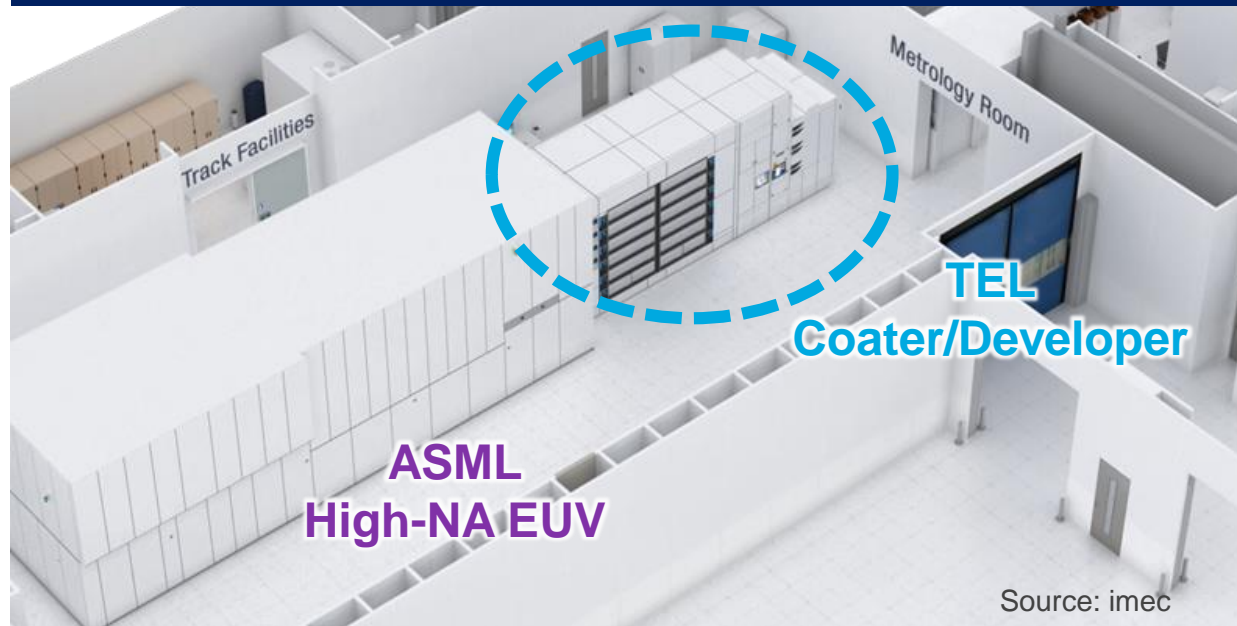
Year of HVM (20k wpm)



\*MP: Multiple patterning

# imecおよびASML社とのHigh-NA EUVの共同開発

## imec-ASML Joint High-NA EUV Research Laboratory



## 2021年6月プレスリリース

東京エレクトロン、imec-ASML 共同高NA EUVラボとの連携  
のお知らせ

東京エレクトロン (TEL、東京都港区、社長：河合利樹) は、オランダのフェルドホーフェンにある「imec-ASML joint high NA EUV research laboratory」(imec-ASML 共同高 NA EUV 研究所。以下、「高NAラボ」)にて、2023年より稼働予定の次世代高NA EUV露光装置 ASML EXE:5000 (開口数NA=0.55) にインライン\*する塗布現像装置を導入することをお知らせします。TELは、imec-ASMLと連携して技術開発を進めることにより、お客様のさらなる微細化へのご要求に対応してまいります。

## 最先端デバイスの開発に向けたコラボレーションを促進

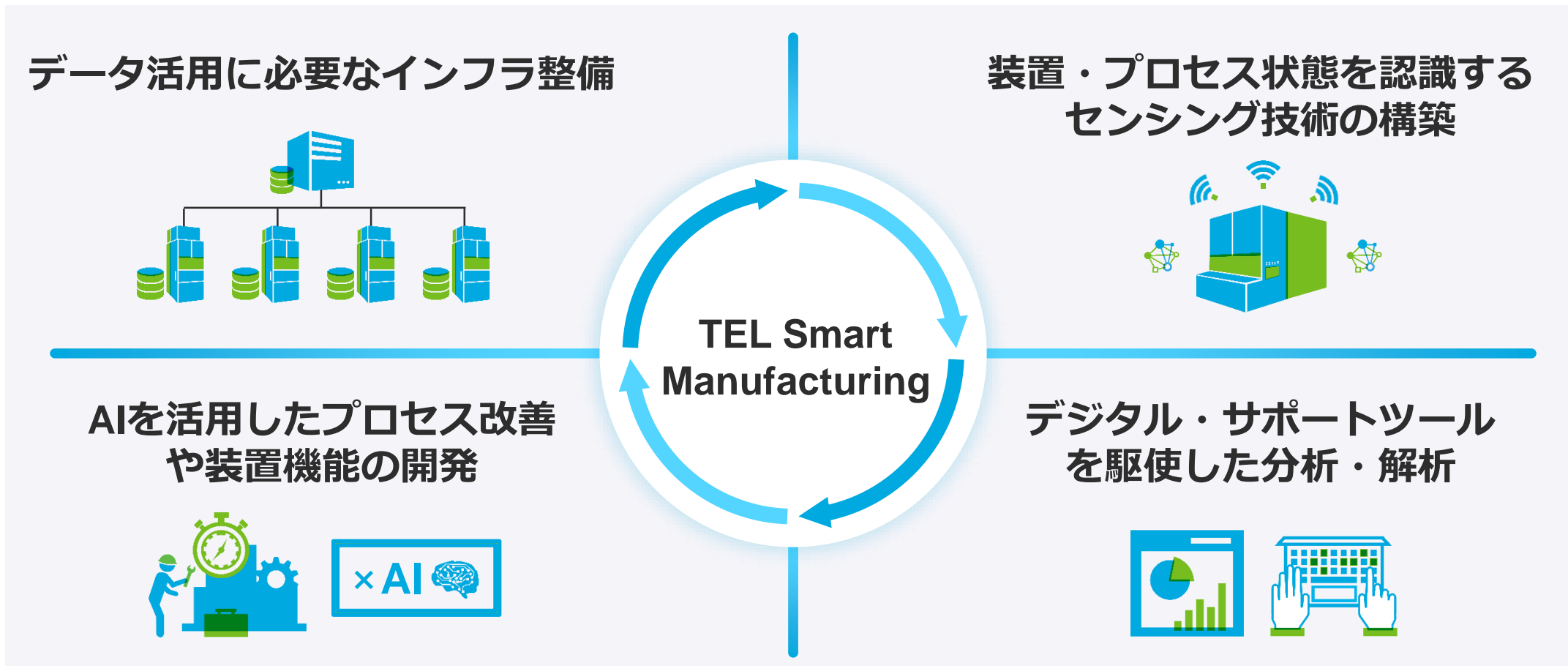
# 事業機会と注力分野（～FY2025）

	Logic	DRAM	NAND
デバイスへの要求	低電力・高速CPU	高速ワーキングメモリ (DDR5)	大容量ストレージ
技術変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GAA Nanosheet</li> <li>■ Backside PDN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EUV</li> <li>■ HKMG CMOS周辺回路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高積層化</li> <li>■ Multi-tier stack</li> <li>■ 周辺回路貼り合わせ</li> <li>■ メモリセル向け 新材料導入</li> </ul>
事業機会	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高選択比エッチング</li> <li>■ 新材料成膜</li> <li>■ 超臨界洗浄</li> <li>■ ボンディング・ Laser Edge Trimming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EUV向けコータ/デベ ロッパ</li> <li>■ 新材料成膜</li> <li>■ 超臨界洗浄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HARCエッチング</li> <li>■ Wetエッチング、 新規乾燥技術</li> <li>■ 新低抵抗メタル</li> <li>■ ボンディング</li> <li>■ ウェーハ反り抑制技術</li> </ul>

当社事業の成長機会はますます拡大



# フィールドソリューション事業のさらなる拡大



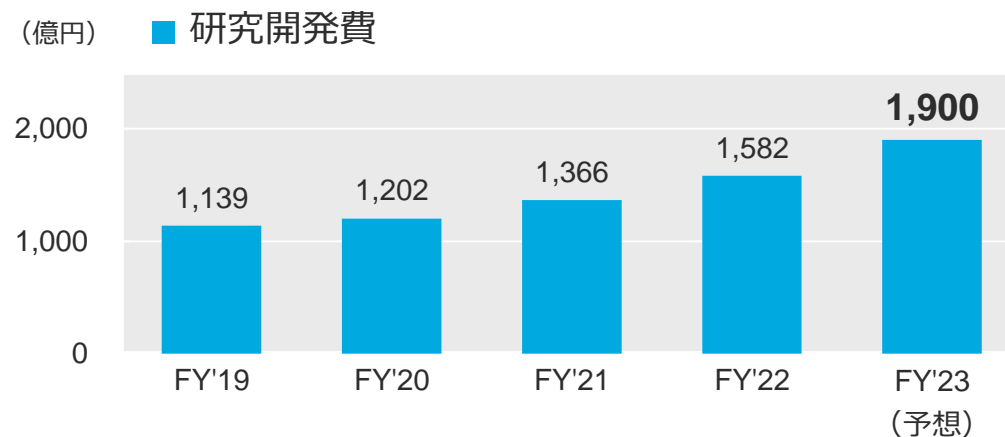
IoT、通信、Metaverse、Green向けなど、事業機会は拡大中。  
DXを推進し装置のパフォーマンス最大化と生産性の向上を図る

# 中期経営計画

財務目標（~FY2027）	
売上高	≥ 3兆円
営業利益率	≥ 35%
ROE	≥ 30%

# FY2023 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,900億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資
- 設備投資 750億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 460億円



新開発棟  
(コート/デベロッパ、サーフェスプレパレーション)

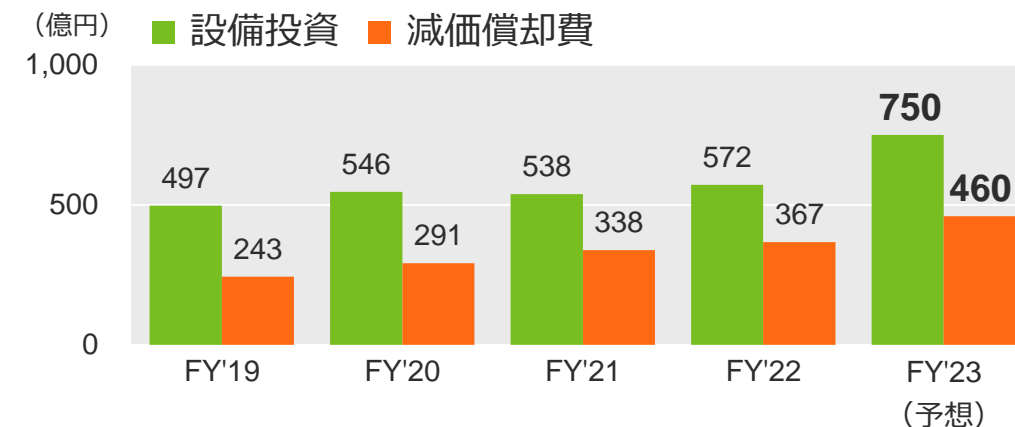


熊本県合志市：建設費約300億円  
(2024年秋 竣工予定)

新開発棟  
(エッチング)



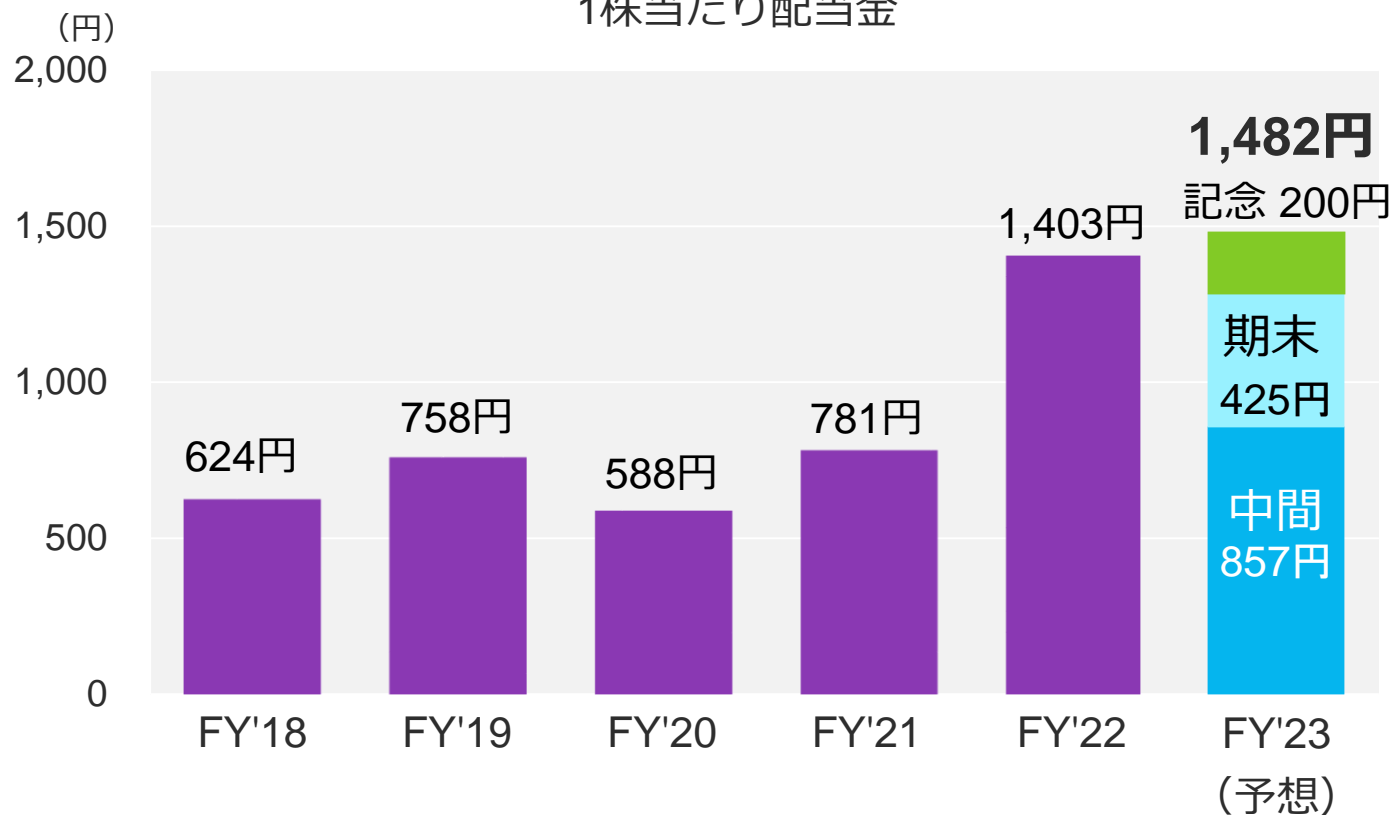
宮城県大和町：建設費約470億円  
(2025年春 竣工予定)



今後5年で、研究開発費は1兆円超、設備投資は4,000億円超を想定。  
さらなる成長に向け生産効率の向上を図る

# FY2023 配当予想

1株当たり配当金



## 当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

60周年記念配当 200円を加え、通期配当金は 1,482円を予定

TEL | 60<sup>↑</sup> years